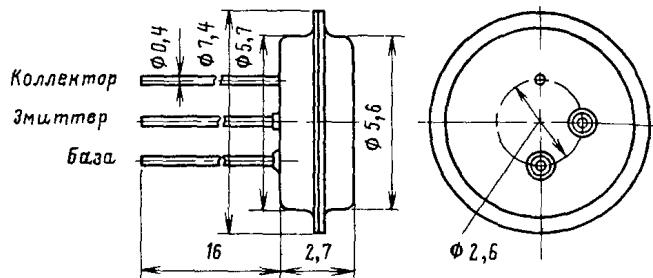


КТ104А, КТ104Б, КТ104В, КТ104Г

Транзисторы кремниевые эпитаксиально-планарные $p-n-p$ универсальные низкочастотные маломощные

Выпускаются в металлокерамическом корпусе с гибкими выводами
Обозначение типа приводится на корпусе

Масса транзистора не более 5 г



Электрические параметры

Границная частота коэффициента передачи тока в схеме с общим эмиттером при $U_{K3} = 5$ В, $I_3 = 1$ мА не менее	5 МГц
Постоянная времени цепи обратной связи при $U_{KB} = 5$ В, $I_B = 1$ мА, $f = 3$ МГц не более	3 нс
Коэффициент передачи тока в режиме малого сигнала при $U_{KB} = 5$ В, $I_3 = 1$ мА	
КТ104А	9 – 36
КТ104Б	20 – 80
КТ104В	40 – 160
КТ104Г	15 – 60
Границное напряжение не менее	
при $I_3 = 5$ мА КТ104А, КТ104Г	30 В
при $I_3 = 10$ мА КТ104Б, КТ104В	15 В
Напряжение насыщения коллектор-эмиттер при $I_K = 10$ мА не более	
при $I_B = 2$ мА КТ104А	0,5 В
при $I_B = 1$ мА КТ104Б, КТ104В, КТ104Г	0,5 В
Напряжение насыщения база-эмиттер при $I_K = 10$ мА не более	
при $I_B = 2$ мА КТ104А	1 В
при $I_B = 1$ мА КТ104Б, КТ104В, КТ104Г	1 В
Обратный ток коллектора не более	
при $U_{KB} = 30$ В КТ104А, КТ104Г	1 мкА
при $U_{KB} = 15$ В КТ104Б, КТ104В	1 мкА
Обратный ток эмиттера при $U_{EB} = 10$ В не более	1 мкА

Материал взят из источника:

Полупроводниковые приборы: Транзисторы. Горюнов Н. Н. (ред)

Энергоатомиздат, 1985

Входное сопротивление в режиме малого сигнала в схеме с общим эмиттером при $U_{КБ} = 5$ В, $I_E = 1$ мА, $f = 1$ кГц	120 * Ом
Емкость коллекторного перехода при $U_{КБ} = 5$ В не более	50 пФ
Емкость эмиттерного перехода при $U_{ЭБ} = 0,5$ В не более	10 пФ

Пределевые эксплуатационные данные

Постоянное напряжение коллектор-база:	
KT104A, KT104Г	30 В
KT104Б, KT104В	15 В
Постоянное напряжение коллектор-эмиттер при $R_{ЭБ} \leq 10$ кОм:	
KT104A, KT104Г	30 В
KT104Б, KT104В	15 В
Постоянное напряжение эмиттер-база	10 В
Постоянный ток коллектора	50 мА
Постоянная рассеиваемая мощность	150 мВт
Общее тепловое сопротивление	400 К/Вт
Температура перехода	393 К
Температура окружающей среды	От 213 до 373 К

Материал взят из источника:

Полупроводниковые приборы: Транзисторы. Горюнов Н. Н. (ред)
Энергоатомиздат, 1985